



(11) **EP 0 976 149 B8**

(12) **FASCICULE DE BREVET EUROPEEN CORRIGE**

(15) Information de correction:

**Version corrigée no 1 (W1 B1)**  
**Bibliographie code(s) INID 73**

(51) Int Cl.:

**H01L 21/28 (2006.01) H01L 29/49 (2006.01)**

(48) Corrigendum publié le:

**25.03.2009 Bulletin 2009/13**

(86) Numéro de dépôt international:

**PCT/FR1999/000330**

(45) Date de publication et mention  
de la délivrance du brevet:

**29.10.2008 Bulletin 2008/44**

(87) Numéro de publication internationale:

**WO 1999/043024 (26.08.1999 Gazette 1999/34)**

(21) Numéro de dépôt: **99903756.7**

(22) Date de dépôt: **15.02.1999**

(54) **PROCEDE POUR LIMITER L'INTERDIFFUSION DANS UN DISPOSITIF SEMI-CONDUCTEUR A GRILLE COMPOSITE SI/SIGE**

VERFAHREN ZUR VERMINDERUNG DER INTERDIFFUSION IN EINEM  
HALBLEITERBAUELEMENT MIT SI/SIGE VERBINDUNGS-GATTER

METHOD FOR LIMITING INTERNAL DIFFUSION IN A SEMICONDUCTOR DEVICE WITH  
COMPOSITE SI/SIGE GATE

(84) Etats contractants désignés:  
**BE DE GB IT NL**

(56) Documents cités:

**US-A- 5 521 108 US-A- 5 567 638**

(30) Priorité: **19.02.1998 FR 9802026**

(43) Date de publication de la demande:  
**02.02.2000 Bulletin 2000/05**

(73) Titulaire: **COMMISSARIAT A L'ENERGIE  
ATOMIQUE  
75015 Paris (FR)**

- KISTLER N ET AL: "SYMMETRIC CMOS IN FULLY-DEPLETED SILICON-ON-INSULATOR USING P+- POLYCRYSTALLINE SI-GE GATE ELECTRODES" PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ELECTRON DEVICES MEETING, WASHINGTON, DEC. 5 - 8, 1993, 5 décembre 1993, pages 727-730, XP000481716 INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS cité dans la demande
- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 401 (E-1404), 27 juillet 1993 -& JP 05 075136 A (OKI ELECTRIC IND CO LTD), 26 mars 1993
- JIN Z ET AL: "LOW-TEMPERATURE ANNEALING OF POLYCRYSTALLINE SI1-XGEX AFTER DOPANT IMPLANTATION" IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, vol. 44, no. 11, novembre 1997, pages 1958-1963, XP000722070
- HELLBERG P -E ET AL: "WORK FUNCTION OF BORON-DOPED POLYCRYSTALLINE SiGe1-X FILMS" IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, vol. 18, no. 9, septembre 1997, pages 456-458, XP000696525

(72) Inventeurs:

- BENSANEL, Daniel  
F-38000 Grenoble (FR)
- CAMPIDELLI, Yves  
F-38000 Grenoble (FR)
- MARTIN, François  
F-38000 Grenoble (FR)
- HERNANDEZ, Caroline  
F-38000 Grenoble (FR)

(74) Mandataire: **Casalonga, Axel  
Bureau Casalonga & Josse  
Bayerstrasse 71/73  
80335 München (DE)**

Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

**EP 0 976 149 B8**